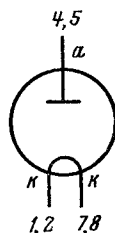


Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации	2,5g
интервал рабочих температур окружающей сре- ды	от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$

2Д9С

Диод высокостабильный для работы в радиотехнических устройствах в режиме насыщения.
Оформление — в стеклянной оболочке (рис. 4Ц).
Масса 50 г.



Основные параметры при $U_{\text{н}} \leq 3,7\text{ В}$, $U_{\text{а}} \leq 500\text{ В}$

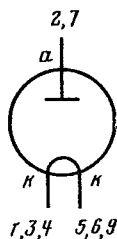
Ток накала	$\leq 550\text{ мА}$
Ток анода	1 мА
Относительная крутизна эмиссионной характеристики	$\geq 7\%$
Сопротивление анод — катод	$\geq 50\text{ МОм}$
Наработка	$\geq 500\text{ ч}$

Критерий оценки:

относительная крутизна эмиссионной характеристики	$\geq 5\%$
---	------------

4Д17П

Диод прямонакальный для работы в качестве чувствительного элемента в схемах стабилизаторов напряжения переменного тока.
Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 17П). Масса 18 г.



Основные параметры при $U_{\text{н}} = 4\text{ В}$, $U_{\text{а}} = 60\text{ В}$

Ток накала	$(1,75 \pm 0,15)\text{ А}$
Ток анода	$\geq 7\text{ мА}$
Крутизна характеристики тока насыщения	$\leq 0,03\text{ мА/В}$
Крутизна характеристики тока анода (при $U_{\text{н}} = 3,9 \div 4,1\text{ В}$)	$\geq 10\text{ мА/В}$